#### ⑫公開特許公報(A) 昭62-111442

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内勢理番号

匈公開 昭和62年(1987)5月22日

H 01 L 21/68 7168-5F A-8207-3C

審查請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

69発明の名称

ウエハ保持治具

②特 顖 昭60-250733

29出 頤 昭60(1985)11月11日

⑫発 明 者 前 田 敏 夫 茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニアリング株式

会社内

の出 顖 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂出 頣

①出

日立デバイスエンジニ

茂原市早野3681番地

アリング株式会社

小平市上水本町1479番地

日立マイクロコンピユ 願

ータエンジニアリング 株式会社

⑪代 理 人

弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

発明の名称 ウェハ保持治具

#### 特許請求の範囲

**真空吸着用パイプ穴が形成されたウエハホルダ** と、このウエハホルダに固定されウエハ吸着面に 前記ウエハホルダの真空吸着用パイプ穴と連通す る真空吸着用癖が形成されたシリコンラバーとを 備えていることを特徴とするウエハ保持治具。 発明の詳細な説明

## [発明の利用分野]

本発明はウエハ保持治具に関する。

#### [ 発明の背景 ]

ウエハはウエハ保持治具に保持され、例えばイ オンミリング装置によつて微細パターンが形成さ れる。

かかるウエハ保持治具として、例えば第1図に 示すような静電吸着によるウェハ保持治具が知ら れている (特開昭 5 9 - 1 0 5 3 2 2 号公報参照)。 即ち、セラミツク基板1上には交互に高単圧を印 加する一対の静電医2a、2bが複数組配列され

ており、その上をラバー絶禄暦3で被覆してなる。 とのように静電極2a、2b及びラバー絶級層3 が形成されたセラミツク基板 1 をウエハホルダ4 に固定し、ウエハホルダ4とセラミツク基板1と で形成される冷却水樽5に冷却水を導き、セラミ ツク基板1を冷却している。

しかしながら、かかる静電吸瘡によるウエハ保 持では、ウエハ6のラバー絶縁層3への吸着力が 弱く、ウエハ冷却効果が悪いという問題点があつ た。

### 〔発明の目的〕

本発明の目的は、強い吸着力が得られるウェハ 保持具を提供することにある。

本発明の他の目的は、ウェハの取付け及び取外 しが容易に行えるウェハ保持治具を提供すること にある。

#### 〔 発明の概要 〕

ウエハホルダに真空吸着用パイプ穴を形成し、 · このウエハホルダにシリコンラバーを接着剤等で 一体に固定してなる。シリコンラバーのウェハ吸 潜面にはウェハホルダの真空吸着用パイプ穴に連通するように真空吸着用牌が形成されている。 〔発明の実施例〕

以下、本発明の一更施例を第2図及び第3図により説明する。ウエハホルダ10には真空吸着用パイプ穴10aが形成されている。このウエハホルダ10上にはシリコンラバー11が接着等で一体に固定されており、シリコンラバー11のウエハ吸着面にはウエハホルダ10の真空吸着用パイプ穴10aに連通するように真空吸着用滞11aが形成されている。

そこで、ウェハ吸着時には、シリコンラバー11 上にウェハ12を設置し、真空吸着用パイプ穴 10 aより引きを行う。これにより、ウェハ12はシ リコンラバー11に押付けられる。その後は真空 引きを止めてもシリコンラバー11の分子間引力 によりウェハ12はシリコンラバー11を介して ウェハホルダ10に保持される。このように、シ リコンラバー11の分子間引力によりウェハ12 は保持されるので、吸着力は強力であり、ウェハ

1 1 …シリコンラバー、 1 1 a …真空吸着用海、 1 2 … ウエハ。

代理人 弁理士 小 川 勝 男



冷却が向上する。

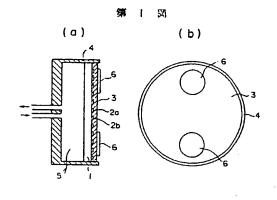
ウエハ取外し時には、其空吸消用パイプ穴 10 aからエアを吹き込むことにより、ウエハ 1 2だけシリコンラバー 1 1 面から浮き上り、容易に取外すことができる。またシリコンラバー 1 1 はウエハホルダ 1 0 に一体に固定されていることにより、ウエハ 1 2 の取付けもウエハ 1 2 のみでよく、容易である。

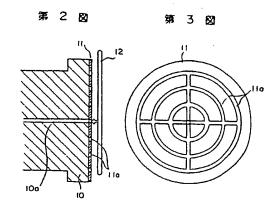
#### 〔発明の効果〕

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、シリコンラバーの分子間引力によりウエハを保持するので、吸着力が強力で冷却効果が高い。またシリコンラバーはウエハホルダに一体に固定されているので、ウエハの取付け及び取外しが容易に行える。

# 図面の簡単な説明

第1図は従来例を示し、(a)は断面図、(b)は正面図、第2図は本発明の一東施例を示す断面図、第3図は第2図のシリコンラバーの正面図である。10…ウェハホルダ、10a…真空吸着用パイプ穴、





第1頁の続き

小平市上水本町1479番地 日立マイクロコンピュータエン 大古田 隆 司 ⑫発 明 者

ジニアリング株式会社内

茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場内 沢 悠夫 ⑫発 明 者 野

THIS PAGE BLANK (USPTO)